

中信证券股份有限公司
关于重庆臻宝科技股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“臻宝科技”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，自臻宝科技发行上市之日（2026 年 6 月 24 日）起，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；

（4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 下游行业周期性波动风险

半导体、显示面板行业具备较强周期性特征，下游晶圆制造、面板厂商资本开支计划受宏观经济环境、终端消费需求、行业景气度、国际贸易政策及全球技术管制等多重因素影响。若下游市场需求走弱，客户缩减资本开支、产线稼动率下降，延缓设备采购及耗材更新节奏，将导致公司真空腔体零部件、表面处理服务需求下降。同时半导体先进制程持续迭代，对零部件纯度、加工精度、防护涂层性能要求持续升级，若未来行业出现重大技术路线变更，而公司未能及时跟进技术升级，现有产品与工艺存在被替代的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

(二) 半导体行业被美国等发达国家进一步制裁的风险

近年来，随着美国芯片法案等贸易限制政策不断加码，地缘政治不确定性持续加剧，全球半导体供应链不稳定性显著提升，集成电路行业已逐步成为中美技术竞争的焦点。公司主要从事设备零部件制造及表面处理服务，主要客户为国内集成电路制造企业。如果未来相关国家和地区出于贸易保护、地缘政治等原因，采取限制国内晶圆厂购买先进半导体设备、停止关键设备维修保养服务或者停供需定期更换的“卡脖子”设备零部件等措施，国内先进制程芯片的稳定生产、工艺

升级及产能扩张将受到影响。公司半导体行业主要客户是国内先进制程集成电路制造企业，则公司也可能面临下游终端订单需求下降等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

（三）客户集中及客户认证相关风险

公司产品主要供给国内头部晶圆制造企业、显示面板厂商，客户集中度相对较高。若主要客户调整采购策略、引入竞品供应商、下调采购价格或减少采购规模，将会对公司营收及盈利水平造成冲击。半导体设备零部件准入流程严苛，新产品工艺验证周期较长，若公司新品研发成果无法持续通过下游客户工艺验证，或是难以同步匹配客户新工艺迭代需求，将限制新产品规模化落地，存在丢失市场份额的风险。若下游核心客户自身经营状况、扩产规划发生重大调整，也将直接影响公司订单规模。

（四）技术研发及核心人才流失风险

公司核心竞争力依托持续自主研发创新，需长期在半导体原材料制备、硬脆材料超精密加工、高致密防护涂层等方向持续投入研发。前沿技术研发存在不确定性，相关研发项目可能出现技术攻关受阻、产业化进度不及预期等情形；即便研发取得突破，新产品亦可能面临客户端验证周期长、商业化落地缓慢的问题。同时，国内半导体高端技术人才竞争日趋激烈，若公司无法持续完善人才激励体系，存在核心技术人员流失、关键工艺经验外泄的风险，进而延缓研发进程，削弱公司长期技术壁垒。

（五）产能扩张带来的盈利承压风险

本次公开发行募集资金将用于生产基地扩建、研发中心建设，未来公司固定资产规模持续增加，每年折旧、摊销费用相应上升。募投项目产能释放需要一定建设、调试周期，如果下游市场需求扩张速度不及预期，新增产能利用率偏低，单位产品分摊的固定成本将有所抬升，对产品毛利率形成压力。叠加持续研发投入带来的刚性费用增长，若产能规模效应无法充分释放，公司存在盈利水平承压的风险。此外，公司部分辅助原材料、陶瓷原粉等仍需外部采购，上游原材料价格大幅波动、供应紧张亦会对生产成本与交付保障造成不利影响。

（六）上市公司治理与内控管理风险

公司于 2026 年 6 月登陆科创板，上市后业务规模持续扩张，组织架构、投融资运作、信息披露、供应链管理、合规管控复杂度显著提升。若公司治理机制、内部控制体系、管理制度未能随着业务发展持续迭代优化，人才储备、管理能力无法匹配上市公司规范化运营要求，可能出现内控执行不到位、运营管理效率不足等问题。随着后续资本运作、业务拓展持续推进，若无法持续维持稳定高效的治理架构，将制约公司长期稳健发展。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）
营业收入	48,352.85	36,637.09	31.98
归属于上市公司股东的净利润	10,711.43	8,518.47	25.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,171.44	8,543.38	19.06
经营活动产生的现金流量净额	13,698.07	7,094.05	93.09
主要会计数据	2026 年 6 月末	2025 年末	本期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	292,642.40	121,026.94	141.80
总资产	334,404.86	161,867.62	106.59
主要财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.92	0.73	26.03
稀释每股收益（元 / 股）	0.92	0.73	26.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.87	0.73	19.18
加权平均净资产收益率（%）	8.46	8.37	增加0.09个百分点

扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	8.04	8.40	减少0.36个百分点
研发投入占营业收入的 比例 (%)	9.04	7.23	增加1.81个百分点

2026 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增长 31.98%，主要受益于行业景气度上行，下游客户扩产带动采购需求提升，零部件产品销售收入实现增长。

2026 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 93.09%，主要源于销售收入规模增长，本期销售商品、提供劳务收到的款项较上年同期增加 1.51 亿元；同时受固定资产采购对应的进项税额增加影响，本期缴纳的各项税费较上年同期减少 0.14 亿元。

2026 年 1-6 月，公司研发投入占营业收入的比重较上年同期有所提升，主要系公司多个研发项目进入关键攻关阶段，研发人员薪酬、材料等相关投入相应增加。

2026 年 6 月末，归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年度末大幅增长，主要系公司于 2026 年 6 月完成首次公开发行股票并在科创板挂牌上市，募集资金到位，货币资金与股本、资本公积同步增加，带来公司总资产及归属于上市公司股东的净资产规模大幅提升。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、全链条技术优势，跨半导体、显示面板双赛道实现多项产品自主可控

公司是国内少数同时掌握大直径单晶硅棒、多晶硅棒、CVD-SiC 等上游半导体关键材料制备技术，以及硅、石英、陶瓷等硬脆材料超精密加工及多元表面处理技术的企业。

在半导体设备零部件领域，公司攻克微深孔加工、复杂曲面成型等多项工艺难题，实现碱性刻蚀曲面硅上部电极、高致密陶瓷零部件等产品国产化突破；持续加大碳化硅精密零部件、静电卡盘、高致密防护涂层等前沿技术研发投入。相关产品已批量应用于 14nm 及以下先进逻辑芯片、堆叠层数 200 层以上 3D NAND

闪存、20nm 及以下 DRAM 先进存储芯片制造产线。

在显示面板设备零部件领域，公司突破熔射再生核心工艺，实现 AMOLED PVD 双极静电卡盘自主可控。通过自主设计电极结构、自研涂层粉体配方、优化喷涂工艺，实现涂层性能显著提升：氧化铝涂层孔隙率低于 3%、耐等离子腐蚀质量损失小于 $8 \times 10^{-8} \text{mg/s}$ ，氧化钽涂层孔隙率低于 1%；完成 4.5KV 高压静电卡盘技术突破。相关零部件与表面处理方案已配套 G10.5-G11 超大世代 LCD、6G AMOLED 产线刻蚀、薄膜沉积、蒸镀设备。现阶段公司持续推进高致密涂层、静电卡盘、氮化铝陶瓷加热器的研发与产能建设，相关技术已取得阶段性产业化成果。

2、一体化平台优势，具备多品类、全业务综合供应能力

公司构建原材料自研自产+精密零部件制造+表面处理再生服务完整业务平台，能够为真空腔体提供多元化零部件配套，形成区别于单一工序、单一品类零部件厂商的独特优势。

原材料端，公司自主量产大直径单晶硅棒、多晶硅棒、CVD 碳化硅基材、氧化铝陶瓷造粒粉、氧化钽陶瓷造粒粉等关键原料，保障上游供给安全，同时满足差异化原材料性能需求。

零部件端，可规模化供应硅基、石英、碳化硅、陶瓷多系列腔体零部件。下游客户可实现多品类零部件集中采购，减少多供应商重复认证成本，降低不同厂商零部件之间的适配磨合风险，便于统一质量管控与问题追溯，有效压降客户综合采购成本与供应链风险。

表面处理端，公司具备精密清洗、阳极氧化、等离子熔射再生等成熟工艺，同时实现高致密涂层技术产业化，可根据不同制程工况定制防护方案，提升零部件在先进制程极端等离子环境下的使用寿命，已成功拓展多家国内头部晶圆制造企业表面处理业务。

一体化协同模式有效保障产品一致性、供应链稳定性，持续提升客户采购与运维效率。

3、优质客户资源优势，国内外头部厂商广泛覆盖，先进工艺持续渗透

半导体领域，公司产品与服务批量供货国内主流存储厂商、晶合集成、华润微电子、芯联集成、武汉新芯、积塔半导体、粤芯半导体等国内主流晶圆制造企业，产品深度配套 14nm 及以下逻辑先进制程、200 层以上 3D NAND、20nm 及以下 DRAM 先进存储产线。同时实现海力士（大连）、格罗方德、联华电子、德州仪器等国际制造厂商产品认证及批量供货。

显示面板领域，公司服务京东方、TCL 华星、天马微电子、惠科股份、彩虹光电等头部面板企业，产品覆盖 G8.5 - G11 高世代 LCD、6G AMOLED 高端产线；实现 G10.5-G11 超大世代、4.5KV - 5KV 超高压工艺、OLED 产线静电卡盘、PVD 双极静电卡盘等关键零部件自主配套。

报告期内，公司与核心客户合作保持稳定，供应品类持续拓宽，订单规模稳步增长。

4、深度协同开发优势，前置参与客户工艺迭代，支撑产线持续改进

依托多元化零部件产品矩阵与整体解决方案能力，公司与国内主流晶圆厂、面板厂商建立长期战略合作，并配置专属技术服务团队跟进客户需求，深度理解客户工艺路线、设备配置、技术迭代目标。

报告期内，公司主动承接客户重点工艺攻关项目，联合开发超厚曲面硅上部电极、氧化钼陶瓷部件、碳化硅零部件等定制化产品，助力刻蚀、薄膜沉积设备关键零部件国产化，筑牢客户供应链安全底线。叠加上游自研半导体材料能力，可灵活匹配客户对基材尺寸、电阻率等特殊指标要求，进一步强化定制化研发与快速交付能力，持续夯实协同开发壁垒。

5、资深研发团队优势，持续保障创新投入

截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 145 名，拥有已授权发明专利 64 项，在申请发明专利 65 项。报告期内，公司研发费用 4,373.03 万元，同比增长 65.05%，研发费用率 9.04%。

公司通过内部培养、外部引才搭建核心研发队伍，核心成员均为行业资深专

家，具备扎实理论功底与丰富产业化经验，先后牵头完成半导体硬脆材料加工、高纯陶瓷制备、等离子防护涂层、零部件表面处理等多项核心工艺研发，为公司持续技术创新、新产品落地提供坚实人才支撑。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月	变化幅度（%）
费用化研发投入	4,373.03	2,649.54	65.05
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	4,373.03	2,649.54	65.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.04	7.23	增加 1.81 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2026年1-6月，研发投入占营业收入的比重较上年同期有所提升，主要系公司多个研发项目进入关键攻关阶段，研发人员薪酬、材料等相关投入相应增加。

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	静电吸盘 L1-L4 级再生技术前段开发	2,380.29	581.58	1,889.89	在研	自主研发适配 12 英寸刻蚀设备的半导体静电吸盘产品体系，突破高性能陶瓷基材制备、电极布线、绝缘层精密加工核心工艺	国内领先	产品用于晶圆承载与静电吸附；新品配套新增设备装机，再生方案挖掘耗材全生命周期价值，满足国内晶圆厂供应链自主可控需求
2	AlN Heater 陶瓷部件开发项目	1,408.30	530.71	799.96	在研	攻克氮化铝陶瓷与金属共烧结、陶瓷异种材料焊接、陶瓷与陶瓷同材质粘接关键技术，解决高导热、绝缘、耐高温协同难题，实现 12 英寸薄膜沉积设备氮化铝加热器国产化开发与验证	国内领先	产品应用于 PVD、CVD 等薄膜沉积工艺腔体，为晶圆提供均匀温控环境，适配先进制程薄膜沉积设备，填补国内高端氮化铝加热部件配套缺口
3	GD 商业机搭建和验证	1,205.00	402.47	512.19	在研	搭建气溶胶沉积商用化设备平台，完成工艺调试与批量制备验证；开发低孔隙率、高致密、低颗粒的耐等离子氧化钼防护涂层制备工艺，对标业界领先高致密涂层技术，形成稳定量产工艺	国内领先	涂层方案适配先进制程刻蚀腔体陶瓷零部件，降低腔体颗粒缺陷，提升零部件抗等离子腐蚀能力，面向头部晶圆厂高精密腔体耗材配套
4	静电吸盘 L1-L3 级再生技术开发	415.00	299.59	322.32	在研	研究静电吸盘等离子工况失效机理与损伤演化模型，开发精密修复、性能恢复升级工艺；掌握陶瓷基体精密加工、电性能复测校准核心技术，实	国内领先	面向存量产线静电吸盘再生需求，降低客户耗材采购成本；广泛配套集成电路刻蚀静电卡盘，完善公司零部件再生服务业务

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
						现静电吸盘分级再生技术自主可控		矩阵
5	气溶胶沉积氧化钼涂层技术开发(GD1)	1,542.00	289.43	356.03	在研	开发气溶胶沉积氧化钼涂层成套制备工艺，实现介质窗口、喷嘴等半导体核心零部件的涂层制备，达到高致密、高耐蚀的涂层性能指标，并通过先进工艺节点的供应链验证与导入	国内领先	应用于先进节点中的干法刻蚀、薄膜沉积等工艺的关键核心零部件
6	新品石英开发	1,200.00	218.78	682.31	在研	突破高纯石英复杂成型、微孔精密加工、表面处理工艺，开发多款适配先进制程设备的新型石英腔体零部件，完成客户端工艺验证	国内领先	石英部件作为刻蚀、薄膜沉积腔体核心耗材，适配逻辑芯片、存储芯片成熟及先进制程产线，丰富公司石英耗材料号矩阵，巩固基石业务市场份额
合计	/	8,150.59	2,322.56	4,562.70	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

本持续督导期间，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股数量未发生变化，且不存在质押、冻结及减持情况。

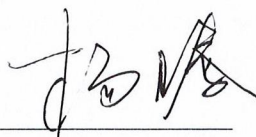
十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于重庆臻宝科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:


杨腾


张腾

